

Elektronika

Auditorne vježbe 6

Zadatak 22.

• U bazi silicijskog pnp tranzistora akumulirani naboj manjinskih nosilaca iznosi $Q_B=5,5$ pC. Vrijeme života šupljina u bazi je 2,5 μ s, a vrijeme proleta 2 ns. Odrediti sve struje i njihove sastavnice na sobnoj temperaturi ako je djelotvornost emitera $\gamma=0,987$. $I_{CBO}\approx0$.

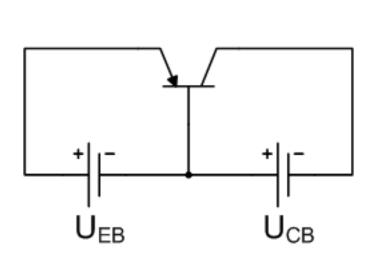
☑ Rješenje:

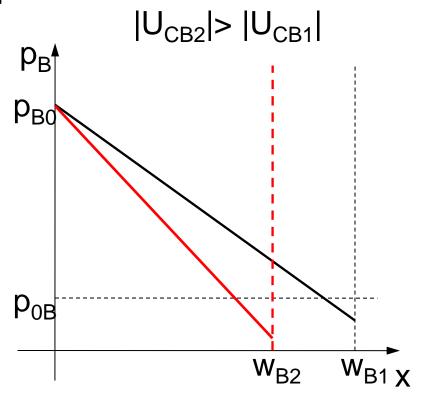
 I_R =2,2μA; I_{pE} =2,75mA; I_E =2,7862mA; I_{nE} =36,2 μA I_{pC} = I_C =2,7478 mA; I_B =38,4 μA.



Earlyjev efekt

- Normalno aktivno područje:
 - E-B propusno polariziran
 - C-B nepropusno polariziran







Zadatak 23.

- Efektivna širina baze silicijskog pnp tranzistora smanji se na četvrtinu zbog promjene napona U_{CB} . Odrediti promjenu napona između emitera i baze ΔU_{EB} da bi na sobnoj temperaturi ostala nepromijenjena:
- a) struja šupljina emitera,
- b) rekombinacijska struja baze.

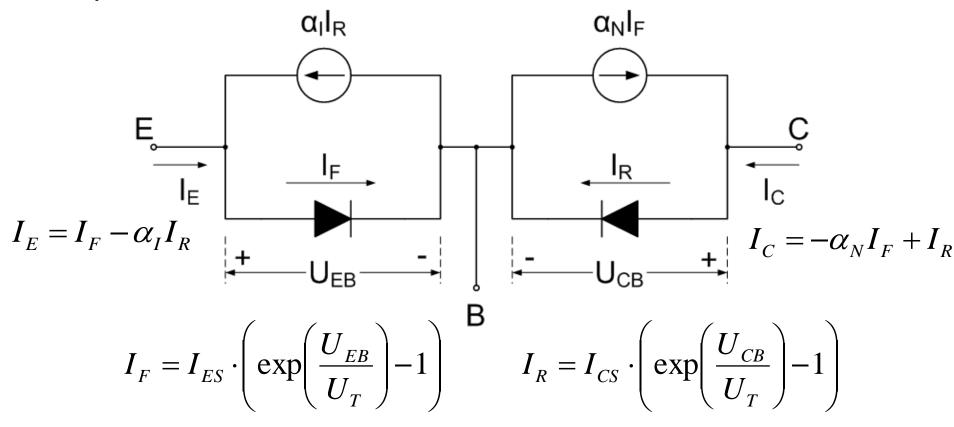
☑ Rješenje:

- a) $\Delta U_{EB} = -35,84 \text{ mV},$
- b) $\Delta U_{EB} = 35,84 \text{ mV}.$



Ebers-Mollov model tranzistora

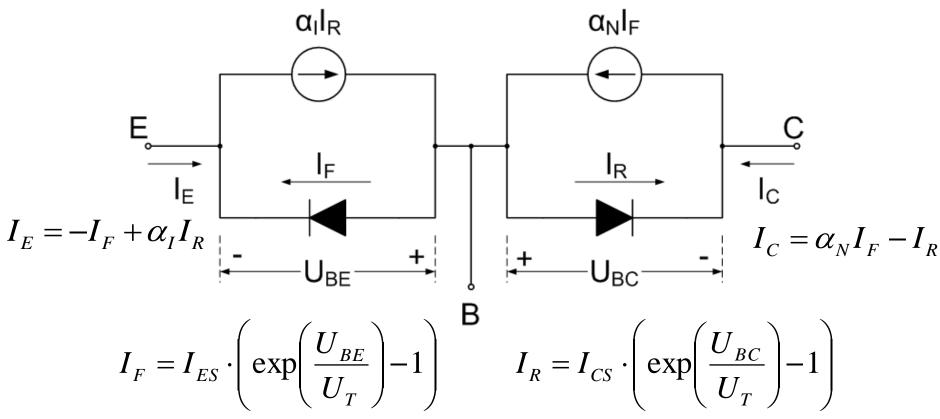
pnp tranzistor





Ebers-Mollov model tranzistora

npn tranzistor





Ebers-Mollov model tranzistora

• Recipročnost: $\alpha_N \cdot I_{ES} = \alpha_I \cdot I_{CS}$

• Definicije struja:

$$I_{ES} = I_{E} \Big|_{U_{EB} < 0; U_{CB} = 0}$$

$$I_{CS} = I_C \Big|_{U_{EB} = 0; U_{CB} < 0}$$

$$I_{EB0} = I_{E} \Big|_{I_{C} = 0; U_{EB} < 0}$$

$$I_{CB0} = I_C \Big|_{I_E = 0; U_{CB} < 0}$$

$$I_{ES} = \frac{I_{EB0}}{1 - \alpha_N \cdot \alpha_I} \qquad I_{CS} = \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_N \cdot \alpha_I}$$

$$I_{CS} = \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_N \cdot \alpha_I}$$



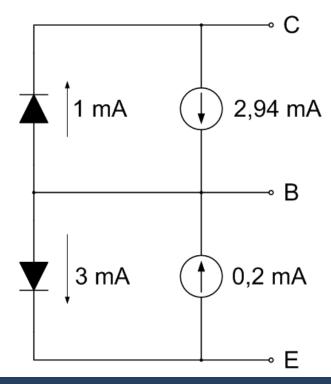
Zadatak 24.

- Na temelju zadanog nadomjesnog sklopa tranzistora treba odrediti:
- a) sve parametre nadomjesnog sklopa;
- b) sve napone i struje.

$$I_{CB0} = 5 \text{ pA}, T = 300 \text{ K}.$$

☑ Rješenje:

- a) α_N =0,98; α_I =0,2; I_{CS} =6,22 pA; I_{EBO} =1,02 pA; I_{ES} =1,27 pA.
- b) $I_E=-2.98$ mA; $I_C=1.94$ mA; $U_{BE}=0.558$ V; $U_{BC}=0.488$ V.

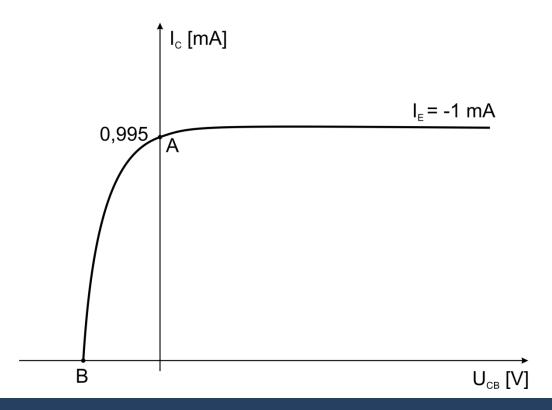




Zadatak 25.

 Odrediti napon U_{CB} u radnoj točki B za npn tranzistor čija je izlazna karakteristika prikazana na slici.

$$I_{CS}$$
=1 pA, I_{ES} =0,85 pA, T=300 K.



☑ Rješenje:

$$U_{CB_B} = -0.583 \text{ V}$$

